

1250M6/с фотоприемный модуль с трансимпедансным усилителем

Модуль представляет собой InGaAs pin-фотодиод, интегрированный с маломощным трансимпедансным усилителем со встроенной системой АРУ и дифференциальным выходом. Согласован с многомодовыми и одномодовыми волокнами, включая волокна с малыми потерями при радиусе изгиба 5мм. Предназначен для преобразования оптических сигналов в электрические в спектральном диапазоне 1260-1620нм в аппаратуре ВОСПИ.

Предельные значения

Рабочая температура, T_c	-40÷+80°C
Температура хранения, T_{stg}	-40÷+100°C

Электрические/оптические параметры (ОМ, $\lambda=1310\text{нм}$, $T=25^\circ\text{C}$)

Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Един.	Условия	
Рабочее напряжение	V_{cc}	3.0	3.3	3.6	В	
Рабочий ток	I_{cc}		42	55	мА	без нагрузки
Дифференциальная чувствительность	R_d	30		50	мВ/мкВт	$R_{load}=100\text{Ом}$, $P=-26\text{дБм}$
Полоса пропускания	BW	700			МГц	
Низкочастотная отсечка	LF		25		кГц	
Время нарастания / спада сигнала	t_r, t_f			400	пс	$P=-26\text{дБм}$, 20%-80%
Мощность насыщения	P_{sat}	0			дБм	
Импеданс	R_0		50		Ом	
Чувствительность				-30	дБм	1244.16 Мб/с, BER= 10^{-10}

Информация для заказа

PMI-1250-W-11-X-X

Тип волокна

Тип коннектора

SM1 – G657A1 (радиус изгиба 13мм*)

SM3 – G657B3 (радиус изгиба 5мм*)

MM5 – 50/125

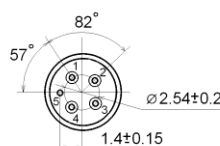
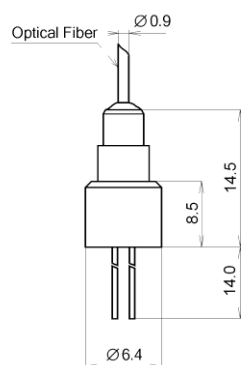
* Потери при 1550нм - 0.1дБ/виток

FU – FC/UPC

FA – FC/APC

N – без коннектора

UNIT:mm



1. Dout
2. Vcc
3. Isink
4. Dout
5. Gnd

Предпочтительная длина волокна – 0.4 м.

По запросу модули изготавливаются в корпусах с фланцем H.